

Katharina Lorenz doutorou-se em Física na Universidade de Bona, Alemanha, em 2002. Nesta altura iniciou o trabalho nos semicondutores III-N com um estudo sobre a dopagem de GaN por implantação iónica. Presentemente é Investigadora Auxiliar no Instituto Superior Técnico e membro do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear deste Instituto. A sua área de especialização é a aplicação de técnicas nucleares na caracterização e modificação de materiais funcionais. Em particular, estuda heteroestruturas e nanoestruturas de semicondutores para aplicações na electrónica e optoelectrónica.